



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104488491 B

(45)授权公告日 2017.02.22

(21)申请号 201410679508.9

审查员 吴锦娣

(22)申请日 2014.11.13

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 104488491 A

(43)申请公布日 2015.04.08

(73)专利权人 安徽泓森高科林业股份有限公司

地址 233600 安徽省亳州市涡阳县站前西路(西阳路东侧)

(72)发明人 石冠旗 侯金波 刘振华 马玉

(74)专利代理机构 北京酷爱智慧知识产权代理有限公司 11514

代理人 刘光裕

(51)Int.Cl.

A01G 1/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种泓森槐硬枝扦插育苗方法

(57)摘要

一种泓森槐硬枝扦插育苗方法,包括七个步骤:步骤一,插穗采集与剪截;步骤二,土地整理;步骤三,采条或挖条;步骤四,插穗处理、扦插;步骤五,浇水覆膜;步骤六,扦插后管理;步骤七,苗木管理;该泓森槐硬枝扦插育苗方法,弥补了现有技术不能实现泓森槐快速繁殖的不足;解决泓森槐硬枝扦插育苗成活的技术问题,在可以促进泓森槐快繁殖的目的,同时保持了母本的优良特征。

1. 一种泓森槐硬枝扦插育苗方法,包括七个步骤:步骤一,插穗采集与剪截;步骤二,土地整理;步骤三,采条或挖条;步骤四,插穗处理、扦插;步骤五,透水覆膜;步骤六,扦插后管理;步骤七,苗木管理;其特征在于:

S1. 在步骤一中:插穗采集与剪截:冬季落叶后半个月剪取当年生枝条,去除稍端幼嫩部分,采用露地混河沙层积灌水法进行冬藏40天以上,翌年春季,挖条剪穗扦插;

S2. 在步骤二中:大地解冻后,施足底肥,深翻并打埂筑畦,畦地面积为7.2x4.6米,埂高25公分,顶宽20公分,畦筑好后,再在畦内筑垄,垄高15公分,顶宽20公分,垄筑好后灌一次透水,以沉实土壤,待稍干后修理整平;垄顶垄底一定要水平,以免灌水时淹没幼嫩枝叶;

S3. 在步骤三中:开春采条或挖条,地面温度0度以上开始扦插,插前将条剪成20公分长的插穗,上切口平圆,下切口呈马蹄形,切口力求平滑,且上切口离第一个芽一公分;

S4. 在步骤四中:插穗处理、扦插:剪好的插穗扦插前用600ppm多菌灵和600ppm萘乙酸水溶液浸泡24h;在预先整好的畦内,用插条锥顺垄的两侧打孔扦插,插穗埋入土16公分,地上留一芽;

S5. 在步骤五中:扦插后浇一次透水,待地面稍干后,顺垄的两侧覆盖白色地膜;

S6. 在步骤六中:扦插后的管理,所有插穗扦插后均以水分管理为中心,从扦插之日起,每两天浇一次水,经常保持土壤湿润,直至发根成活,浇水量不淹没新发枝叶;插穗成活后,减少浇水次数和浇水量,并逐步过渡到正常管理;

S7. 在步骤七中:加强苗木管理,发芽后,要及时在芽的上方破地膜;苗木长到5片叶之前,喷施50ppm萘乙酸,每隔5d喷1次,连喷3次;苗木生长期,干旱时及时浇水,苗木长到30cm后,每667平米追施尿素10~15kg,过磷酸钙40~50kg;每隔20d施1次,连施3次;揭地膜后及时锄草;苗木长到40cm后;及时喷施农药,防治病虫害。

一种泓森槐硬枝扦插育苗方法

技术领域

[0001] 本发明涉及农业扦插育苗技术领域,尤其是一种泓森槐硬枝扦插育苗方法。

背景技术

[0002] 泓森槐作为槐树的一种,主要靠种子繁殖,优良种系采用嫁接和埋根法,但泓森槐,异花授粉力强,天然杂交率高,种子的性状不易保持,嫁接和埋根的成本又高,速度也慢,达不到快速繁殖目的;现有技术难以实现泓森苗的快速繁殖,本发明旨在提供一种泓森槐的扦插育苗方法。

发明内容

[0003] 现有技术不能满足人们的需要,为弥补现有技术不足,本发明旨在提供一种泓森槐硬枝扦插育苗方法。

[0004] 为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种泓森槐硬枝扦插育苗方法,包括七个步骤:步骤一,插穗采集与剪截;步骤二,土地整理;步骤三,采条或挖条;步骤四,插穗处理、扦插;步骤五,浇水覆膜;步骤六,扦插后管理;步骤七,苗木管理。

[0005] 其中在步骤一中:插穗采集与剪截:冬季落叶后半个月左右剪取当年生枝条,去除稍端幼嫩部分,采用露地混河沙层积灌水法进行冬藏40天以上。

[0006] 在步骤二中:大地解冻后,施足底肥,深翻并打埂筑畦,畦地面积不宜太大,以免灌水不均,一般以7.2x4.6米为宜,埂高25公分,顶宽20公分,畦筑好后,再在畦内筑垄,垄高15公分,顶宽20公分,垄筑好后灌一次透水,以沉实土壤,待稍干后修理整平。垄顶垄底一定要水平,以免灌水时淹没幼嫩枝叶。

[0007] 在步骤三中,开春采条或挖条,地面温度0度以上开始扦插,插前将条剪成20公分长的插穗,上切口平圆,下切口呈马蹄形,切口力求平滑,且上切口离第一个芽以一公分为宜。

[0008] 在步骤四中,插穗处理、扦插:剪好的插穗扦插前用600ppm多菌灵和600ppm萘乙酸水溶液浸泡24h;在预先整好的畦内,用插条锥顺垄的两侧打孔扦插,插穗埋入土16公分左右,地上留一芽。

[0009] 在步骤五中,扦插后浇一次透水,待地面稍干后,顺垄的两侧覆盖白色地膜。

[0010] 在步骤六中,扦插后的管理:所有插穗扦插后均以水分管理为中心,从扦插之日起,以每两天浇一次水,经常保持土壤湿润,直至发根成活,浇水量以不淹没新发枝叶为宜,插穗成活后,可适当少浇水次数和浇水量,并逐步过渡到正常管理。

[0011] 在步骤七中,加强苗木管理,发芽后,要及时在芽的上方破地膜;苗木长到5片叶之前,喷施50ppm萘乙酸,每隔5d喷1次,连喷3次;苗木生长期,干旱时及时浇水,苗木长到30cm后,每667平米追施尿素10~15kg,过磷酸钙40~50kg;每隔20d施1次,连施3次;揭地膜后及时锄草;苗木长到40cm后;及时喷施农药,防治病虫害。

[0012] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:该泓森槐硬枝扦插育苗方法,弥补了现有

技术不能实现泓森槐快速繁殖的不足;解决泓森槐硬枝扦插育苗成活的技术问题,在可以促进泓森槐快繁殖的目的,同时保持了母本的优良特征。

具体实施方式

[0013] 下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0014] 本发明实施例中,一种泓森槐硬枝扦插育苗方法,包括七个步骤:步骤一,插穗采集与剪截;步骤二,土地整理;步骤三,采条或挖条;步骤四,插穗处理、扦插;步骤五,浇水覆膜;步骤六,扦插后管理;步骤七,苗木管理。

[0015] 其中在步骤一中:插穗采集与剪截:冬季落叶后半个月左右剪取当年生枝条,去除稍端幼嫩部分,采用露地混河沙层积灌水法进行冬藏40天以上。

[0016] 在步骤二中:大地解冻后,施足底肥,深翻并打埂筑畦,畦地面积不宜太大,以免灌水不均,一般以7.2x4.6米为宜,埂高25公分,顶宽20公分,畦筑好后,再在畦内筑垄,垄高15公分,顶宽20公分,垄筑好后灌一次透水,以沉实土壤,待稍干后修理整平。垄顶垄底一定要水平,以免灌水时淹没幼嫩枝叶。

[0017] 在步骤三中:开春采条或挖条,地面温度0度以上开始扦插,插前将条剪成20公分长的插穗,上切口平圆,下切口呈马蹄形,切口力求平滑,且上切口离第一个芽以一公分为宜。

[0018] 在步骤四中:插穗处理、扦插:剪好的插穗扦插前用600ppm多菌灵和600ppm萘乙酸水溶液浸泡24h;在预先整好的畦内,用插条锥顺垄的两侧打孔扦插,插穗埋入土16公分左右,地上留一芽。

[0019] 在步骤五中:扦插后浇一次透水,待地面稍干后,顺垄的两侧覆盖白色地膜。

[0020] 在步骤六中:扦插后的管理:所有插穗扦插后均以水分管理为中心,从扦插之日起,以每两天浇一次水,经常保持土壤湿润,直至发根成活,浇水量以不淹没新发枝叶为宜插穗成活后,可适当少灌水次数和灌水量,并逐步过渡到正常管理。

[0021] 在步骤七中:加强苗木管理,发芽后,要及时在芽的上方破地膜;苗木长到5片叶之前,喷施50ppm萘乙酸,每隔5d喷1次,连喷3次;苗木生长期,干旱时及时浇水,苗木长到30cm后,每667平米追施尿素10~15kg,过磷酸钙40~50kg;每隔20d施1次,连施3次;揭地膜后及时锄草;苗木长到40cm后;及时喷施农药,防治病虫害。

[0022] 实施例一

[0023] 地址:xx农场 1-2年生泓森槐

[0024] 运用传统根埋法:2013年3月中旬,树根取至1-2年泓森槐苗当即挖出的树根,剪成5-6公分一段,运用传统根埋法,种在与扦插同等条件的地里面;

[0025] 种植5750株,成活4720株,成活率82%。

[0026] 运用泓森槐硬枝扦插育苗方法:2012年冬落叶后15天取材,2013年3月中旬开始扦插种植2270株,成活1970株,成活率86%。

[0027] 结论,泓森槐硬枝扦插育苗技术为泓森槐育苗提供了新的育苗方法;必将促进泓

森槐的快速发展。

[0028] 对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其它的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何标记视为限制所涉及的权利要求。

[0029] 以上所述,仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同替换和改进,均应包含在本发明技术方案的保护范围之内。